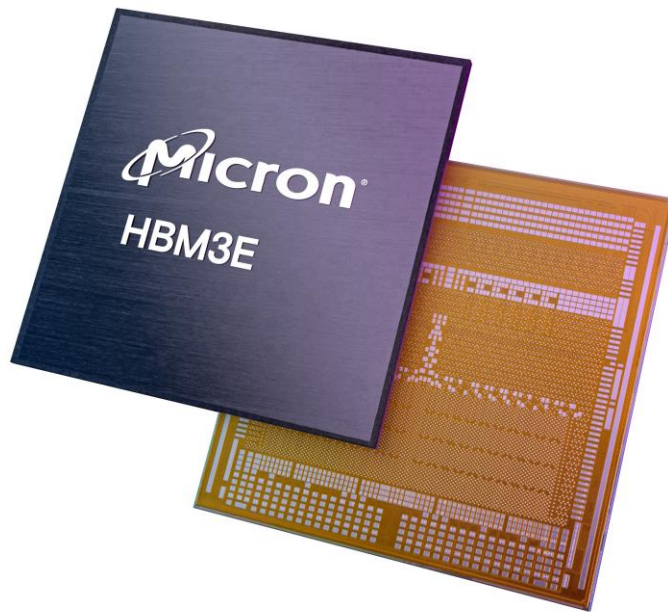




美光开始量产行业领先的 HBM3E 解决方案，加速人工智能发展

美光 HBM3E 比竞品功耗低 30%，助力数据中心降低运营成本

2024 年 3 月 4 日，中国上海 —— 全球内存与存储解决方案领先供应商 Micron Technology, Inc.（美光科技股份有限公司，纳斯达克股票代码：MU）近日宣布已开始量产其 HBM3E 高带宽内存解决方案。英伟达 H200 Tensor Core GPU 将采用美光 8 层堆叠的 24GB 容量 HBM3E 内存，并于 2024 年第二季度开始出货。美光通过这一里程碑式进展持续保持行业领先地位，并且凭借 HBM3E 的超凡性能和能效为人工智能（AI）解决方案赋能。



HBM3E：推动人工智能革命

随着人工智能需求的持续激增，内存解决方案对于满足工作负载需求的增加至关重要。美光 HBM3E 解决方案通过以下优势直面这一挑战：

- **卓越的性能：**美光 HBM3E 引脚速率超过 **9.2Gb/s**，提供超过 **1.2TB/s** 的内存带宽，助力人工智能加速器、超级计算机和数据中心实现超高速的数据访问。
- **出色的能效：**美光 HBM3E 功耗比竞品低约 **30%**，处于行业领先地位。为支持日益增长的人工智能需求和用例，HBM3E 以更低功耗提供更大吞吐量，从而改善数据中心的主要运营支出指标。



- **无缝的可扩展性：**美光 HBM3E 目前提供 **24 GB** 容量，使数据中心能够无缝扩展其人工智能应用。无论是用于训练海量神经网络还是加速推理任务，美光的解决方案都提供了必要的内存带宽。

美光执行副总裁暨首席商务官 Sumit Sadana 表示：“美光凭借 HBM3E 这一里程碑式产品取得了三大成就：领先业界的上市时间、引领行业的性能和出众的能效表现。人工智能工作负载在很大程度上依赖于内存带宽和容量。美光拥有业界领先的 HBM3E 和 HBM4 产品路线图，以及为 AI 应用打造的 DRAM 和 NAND 全套解决方案，为助力人工智能未来的大幅增长做足了准备。”

美光利用其 1 β (1-beta) 技术、先进的硅通孔 (TSV) 和其他实现差异化封装解决方案的创新技术开发出业界领先的 HBM3E 设计。美光作为 2.5D/3D 堆叠和先进封装技术领域长久以来的存储领导厂商，有幸成为台积电 3Dfabric 联盟的合作伙伴成员，共同构建半导体和系统创新的未来。

美光将于 2024 年 3 月出样 12 层堆叠的 36GB 容量 HBM3E，提供超过 1.2TB/s 的性能和领先于竞品的卓越能效，从而进一步强化领先地位。美光将赞助 3 月 18 日开幕的英伟达 GTC 全球人工智能大会，届时将分享更多前沿 AI 内存产品系列和路线图。

关于 Micron Technology Inc. (美光科技股份有限公司)

美光科技是创新内存和存储解决方案的业界领导厂商，致力于通过改变世界使用信息的方式来丰富全人类生活。凭借对客户、领先技术、卓越制造和运营的不懈关注，美光通过 Micron® 和 Crucial® 品牌提供 DRAM、NAND 和 NOR 等多个种类的高性能内存以及存储产品组合。我们通过持续不断的创新，赋能数据经济发展，推动人工智能和 5G 应用的进步，从而为数据中心、智能边缘、客户端和移动应用提升用户体验带来更大机遇。如需了解 Micron Technology, Inc. (美光科技股份有限公司，纳斯达克股票代码：MU) 的更多信息，请访问 micron.com。

©2024 Micron Technology, Inc. 版权所有。资讯、产品和 / 或规格若有变动，恕不另行通知。Micron、Micron 徽标及其他美光商标均为 Micron Technology, Inc. (美光科技股份有限公司) 所有。所有其他商标分别为其各自所有者所有。

微信服务号：



微信订阅号：



微信视频号：





美光媒体联络人

美光科技股份有限公司

冯昊 先生

电话: +86 21 6063 1677

E-mail: ralphfeng@micron.com

高诚公关

陈枢悦 / 美光服务团队

电话: +86 10 8569 9886

E-mail: schen3@golin.com